### Московский Физико-Технический Институт

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Кафедра общей физики Лабораторная работа № 3.3.4

# Эффект Холла в полупроводниках

Студент			Преподаватель		
(кми)	(фамилия)	(кми)	(отчество)		
	группа	-	(фамилия)		



**Цель работы:** Измерение подвижности и концентрации носителей заряда в полупроводниках.

В работе используются: электромагнит с источником питания, амперметр, миллиамперметр, милливеберметр, реостат, цифровой вольтметр, источник питания, образцы легированного германия.

#### 1. Теоретическая часть

**Дырки** Эффект Холла, возникающий в проводниках, происходит из-за наличия некоторого количества свободных электронов в зоне проводимости и такого же количества дырок в валентной зоне. Чтобы понять причину образования дырок, нужно рассмотреть дырочную проводимость.

Дырочную проводимость можно объяснить при помощи следующей аналогии: если представить ряд людей, сидящих в аудитории, где нет запасных стульев. Когда кто-нибудь из середины ряда хочет уйти, он перелезает через спинку стула в пустой ряд и уходит. Здесь пустой ряд — аналог зоны проводимости, а ушедшего человека можно сравнить со свободным электроном. Теперь представим, что ещё кто-то пришёл и хочет сесть. Из пустого ряда плохо видно, поэтому там он не садится. Вместо этого человек, сидящий возле свободного стула, пересаживается на него, вслед за ним это повторяют и все его соседи. Таким образом, пустое место как бы двигается к краю ряда. Когда это место окажется рядом с новым зрителем, он сможет сесть. В этом процессе каждый сидящий передвинулся вдоль ряда. Если бы зрители обладали отрицательным зарядом, такое движение было бы электрической проводимостью. Если вдобавок стулья заряжены положительно, то ненулевым суммарным зарядом будет обладать только свободное место. Это простая модель, показывающая как работает дырочная проводимость. Однако на самом деле, изза свойств кристаллической решётки, дырка не локализована в определённом месте, как описано выше, а размазана по области размером во много сотен элементарных ячеек.

**Эффект Холла** Магнитного поле в проводнике действует на свободные электроны в зоне проводимости, поэтому между гранями наблюдается добавочная разность потенциалов, связанная с силой Лоренца.

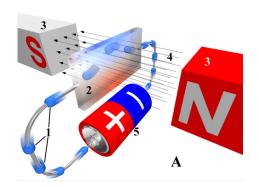


Рис. 1: Пример действия эффекта Холла на свободные заряды

$$F_{\Pi} = -eE - e\langle v \rangle \times B,$$

где e - абсолютная величина заряда электрона,  $\boldsymbol{B}$  - индукция магнитного поля,  $\boldsymbol{E}$  - напряженность электрического поля,  $\langle \boldsymbol{v} \rangle$  - средняя скорость заряда.

Из этого выражения получим разность потенциалов между двумя гранями:

$$U = -E_z l = -|\langle v \rangle| B l \tag{1}$$

С этой возникшей разностью потенциалов и связан Эффект Холла.

Далее, если выразить ток:

$$I = ne|\langle \upsilon \rangle| la$$

И совместить его с (1), получим ЭДС Холла:

$$\mathscr{E}_x = U = -\frac{IB}{nea} = -R_x \cdot \frac{IB}{a},\tag{2}$$

где  $R_x = \frac{1}{ne}$  называется постоянной Холла.

### 2. Установка и параметры измерения

Параметры установки:

$$a =$$

$$L_{35} =$$

$$l =$$

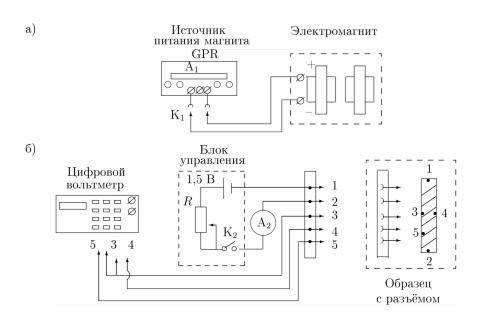


Рис. 2: Схема установки для измерения эффекта Холла в полупроводниках

В нашей установке вдоль длинной стороны образца будет течь ток, величина которого регулируется реостатом  $R_2$ . Так как он помещен в электромагнит, между точками  $3\ u\ 4$  будет возникать разность потенциалов  $U_{34}$ , которую мы будем измерять.

Однако между точками 3 u 4 будет возникать некоторое дополнительное падение напряжения  $U_0$ , так как эти точки оказываются не на одной эквипотенциали. Исключить это влияние можно

с помощью изменения направления магнитного поля: в одном случае  $U_{34} = U_0 - \mathscr{E}_x$ , в другом  $U_{34} = \mathscr{E}_x - U_0$ . Тогда с помощью полуразности избавимся от  $U_0$  в наших измерениях.



Рис. 3: Эффект Холла при различных направлениях магнитного поля и тока через образец

#### 3. Обработка результатов

**Калибровка установки** Во время проведения работы мы сняли зависимость магнитного потока  $\Phi$  от силы тока I, также нам известно, что  $\Phi = BSN$ , где  $SN = 75~{\rm cm}^2 \cdot {\rm But}$ .

Таблица 1: Данные для калибровки установки

<i>I</i> , мА				
Ф, мВб				
В, Тл				

C помощью MHK вычислим зависимость, B =

Таблица 2: Зависимость ЭДС Холла от магнитного поля

	-	гаолица 2	. Oabrer	IMOCID	$\gamma \pm 0$	JIJIA OI N	101 1111111	10 110,171	
I, MA	$U_0$ , MB	$I_M$ , мА							
1, 1111	1, M11 00, MD	В, Тл							
		$U$ , м $\mathrm{B}$							
		$\mathscr{E}_x$ , мВ							
		$U$ , ${ m MB}$							
		$\mathscr{E}_x$ , мВ							
		$U$ , м $\mathrm{B}$							
		$\mathscr{E}_x$ , мВ							
		U, mB							
		$\mathscr{E}_x$ , мВ							
		U, м $B$							
		$\mathscr{E}_x$ , мВ							
		U, mB							
		$\mathscr{E}_x$ , мВ							
		U, mB							
		$\mathscr{E}_x$ , мВ							
		U, mB							
		$\mathscr{E}_x$ , мВ							
		U, mB							
		$\mathscr{E}_x$ , мВ							

### Место для графика

Рис. 4: Калибровка установки

Проанализируем полученные данные с помощью МНК. Отобразим их в таблице 3:

Таблица 3: Зависимость углового коэффициента от силы тока

I, MA		_		
k, мВ · Тл/мА				
$\sigma_k$ мВ $\cdot$ Тл/мА				
$\sigma_I$ , м $A$				

Также изобразим эти данные на графике (рис. 6). Опять же с помощью МНК получаем, что

$$K =$$

Из формулы (2) посчитаем постоянную Холла:

$$R_x =$$

### Место для графика

Рис. 5: График зависимости  $\mathscr{E}_x = f(B)$  для разных I

## Место для графика

Рис. 6: График зависимости углового коэффициента от силы тока
Определим концентрацию носителей заряда: $n=$
Вычислим удельную проводимость материала с помощью $U_{35}=$ :
$\sigma =$
Рассчитаем подвижность электрона:
b =
$\Delta b =$
4. Вывод